相変化光記録ディスクの電子分光

<u>谷 克彦</u>。伊藤和典 a, 岩田周行 a, 加藤拓司 a, 田中彰博 b, 木村昌弘 c, VLAICUAurel Mihai b, 吉川英樹 b, 福島 整 b

^aリコー中研、^b 独立行政法人物質・材料研究機構、°スプリングエイトサービス㈱、

背景: 情報化社会の急速な進展にともない、 高密度の光記録媒体は、社会的に強い要求があ る。このような媒体の一つとして、結晶相/非晶 質相の可逆的な相変化を利用し情報を記録する 相変化型の記録媒体がある。これは、書き換え 可能な記録媒体であり、環境にも優れている。 Sb - Te 系の合金薄膜は、相変化型の記録材料と して実用化されているが、さらに高速・高密度 記録が要求される次世代記録媒体としても非常 に有力である。

これまで SPring-8 にて、非晶質/結晶質の局 所構造解析(BL01B1)、粉末 X 線回折(BL19B2)等 を実施し、構造解明が進んだが、相変化に伴う 構造変化を、ディスク基板上の薄膜のまま、微 小領域のスペクトルを測定し直接観察する手法 は、まだ検討が進んでいない。この方法は、XPEEM による微少領域(100nm オーダーの記録ビット) の直接観察にも対応でき、高エネルギー領域の XPEEM が実用化された場合の重要な基礎技術と なり得る。また、この技術確立がなされれば、 記録ビットだけでなく周囲の各点の XAFS (XANES) スペクトルを、主成分の Sb、Te だ けでなく、存在量の少ない Ag, In などの副成分 に関して得ることができる。これは、相変化の 繰り返しによる劣化機構解析に直結し工業的に も意義深い。また、相変化に伴う材料構成各元 素の電子構造変化の基礎データを得ることもで き、相転移の機構解明に寄与する。

したがって、早期にこの技術確立を行う必要 があり、本実験は、その一環となる要素技術の 確立を目的とする。

実験: 試料は、ポリカーボネート CD 基板上に 堆積した Ag₅In₅Sb₆₀Te₃₀ 合金薄膜で、厚みは約 16nm である。今回は、結晶ー非晶質の相変化に おいて重要な役割があると推定される Ag 原子の 挙動の解析を目的とし、試料における Ag の XANES スペクトル測定について検討した。実験は、 SPring-8 BL15XUに設置されている角度分解光電 子分光装置 (DAPHNIA) により実施した。励起エ ネルギーは Ag L_{III} 吸収端近傍の 3340eV から 3410eV の間を 1eV 間隔で掃引した。

結果と考察: まず、この励起エネルギー条件 において、他の元素の妨害のできるだけ少ない 条件を満足する Ag の光電子ピークもしくは Auger ピークを探索した結果、Ag LMM を用いる のが良いことがわかった。Binding energy で 740 ~860eV の領域での Ag LMM 測定結果を励起エネ ルギー4eV 間隔でプロットしたものを、図1に示 す。図1では、下から上に行くに従って励起エ ネルギーが高くなっている。それに従い、Ag LMM が Sb 3p のすぐ左側に出現し、励起エネルギー が高くなっていくとともに図の左側へ移動した ように観測されるのがわかる。

図1の一番手前のスペクトルは、Ag L_{III} 吸収 端のエネルギー位置より最も低い条件で励起さ れたものである。従って、この条件が与えるス ペクトルの形状をAg の無い場合として扱えると 仮定し解析を行った。すべてのスペクトルにつ いて、その測定時の励起光強度での強度補正を 行った後、この最も低エネルギーで励起された スペクトルを他のすべてのスペクトルから差し 引く。差分として得られた Ag LMM に対して、励



図1 励起エネルギーを変化させて測定された Ag-In-Sb-Te 薄膜の XPS スペクトル

起エネルギーの変化分を補正し運動エネルギー を相対的に一致させてプロットした結果を図2 に示す。メインピークにシフトがほとんど見ら れないことからも、測定系のドリフトの影響は ほとんど無いことがわかる。また、すべての差 分がほぼ同一の形状を示し、過去の測定例やデ ータ集における金属 Ag のスペクトルとほぼ一致 している事もわかる。

図2のメインピークの最大値を縦軸に、励起 エネルギーを横軸にとることで得られる Ag L_{III} 吸収端の XANES スペクトルを図3に示す。図3 から求めた吸収端の位置は 3352eV であり、金属 Ag の文献等の過去の報告例(3351eV)とも良い 対応を示している。対比の為に、文献[1]に報告 されている Ag L_{III} 吸収端の形状を図4に示す。 図3の吸収端より低い部分は特に顕著であるが、 差分操作による S/N の悪化が目立ち、このデー タでは、まだ S/N が足りず、微細構造の形状や、

った。

ー方、図2を見ると、Ag LMM の右側の領域で、 差分領域が大きいほど(励起エネルギーが高い ほど)差分結果に負の値を与える部分が大きい ことがわかる。励起光強度による補正を行って いるスペクトル同士の差分であることから、こ の原因として、励起光強度測定系(Io モニター) と光電子/Auger 電子信号強度の直線性が、励起 エネルギーを変化させたときの影響をある程度 受けてしまっている可能性が考えられる。励起 光強度を本来よりも高く見積もりすぎた場合に 負の領域が出現するが、このような誤差は主に Io モニターを含むビームアライメント調整に依 存する事が多く、スリット条件等の再検討を促 すものと考えられる。また、励起光エネルギー が増加することによる励起断面積の低下やバッ クグラウンド形状の変化等も考えられるが、そ の寄与がどの程度あるかはわからない。

> 測定条件や差分方法にまだ多くの 改善の余地はあるものの、本方法によ り蛍光 XAFS 等で測定の困難な場合 (微小領域等)や薄膜中のマイナー成 分の XANES を高エネルギー励起 XPS にて測定することが可能であること が示された。

B, 9831, 39, (1989)



図3 図2のメインピーク強度より求めた Ag L_{III} 吸収端